

GLR1205BSI-S

250 μm 大像素、线阵CMOS图像传感器



GLR 是长光辰芯线阵芯片 GL 中的全新子系列，是基于长方形像素尺寸设计的线阵图像传感器。**GLR1205BSI-S** 像素尺寸为 $12.5 \mu\text{m}$ (H) $\times$ $250 \mu\text{m}$ (V)，分辨率 512 (H) $\times$ 1 (V)。具备高满阱、高灵敏度、高量子效率、小尺寸等特点。凭借先进的背照式工艺，**GLR1205BSI-S** 在 650 nm 波长下可提供近 50% 的量子效率，以及 95% 的峰值量子效率，为点激光位移传感器提供了理想的解决方案。凭借 $250 \mu\text{m}$ (V) 的大像素尺寸，不仅为芯片提供了高达 2800 ke^- 的满阱容量和 71.1 dB 的最大信噪比，也提升了芯片感光灵敏度，以及便于用户在设备装调时进行光斑对准。得益于创新的像素设计，**GLR1205BSI-S** 具备仅 $2.5 \mu\text{s}$ 电荷转移时间，用户无需担心 lag 性能。芯片采用模拟信号输出，用户可以基于 MCU 模块进行图像数据处理。芯片封装采用紧凑的 CSP 形式，封装尺寸仅为 $7.39 \text{ mm} \times 1.15 \text{ mm}$ ，相较于市面同类型产品尺寸更小。



产品特性及优势

- ▶ 背照式
- ▶ 高灵敏度
- ▶ 大满阱
- ▶ 长方形像素
- ▶ CSP 封装

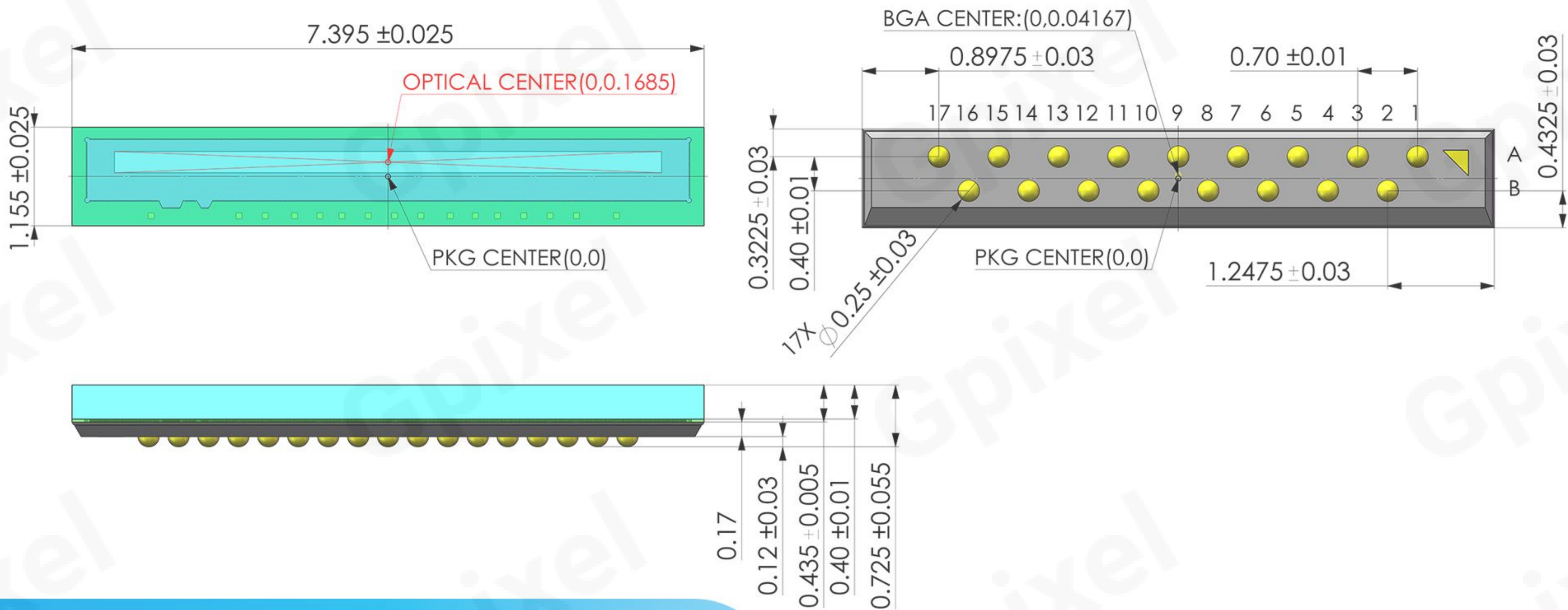
应用领域

- ▶ 点激光位移传感器
- ▶ 光谱测量
- ▶ 光学相干断层扫描(OCT)

规格参数

有效分辨率	512 (H) x 1 (V)	感光面长度	6.4 mm
像素尺寸	12.5 μm x 250 μm	快门类型	全局快门
峰值量子效率	95%	读出噪声	0.58 mV rms
饱和输出电压	2.45 V	动态范围	4224: 1
最高行频	9.43 kHz	暗电流	T.B.D
输出接口	模拟输出	最大数据率	5 MHz
色彩	黑白	功耗	90 mW
供电电压	3.3 V	封装形式	17 pins CSP (7.39 mm x 1.15 mm)

封装信息



联系方式

长春 (总部) 长春长光辰芯微电子股份有限公司 吉林省长春市经开区自由大路7691号 光电信息产业园一期1号、5号办公楼 电话：0431-85077785	杭州 杭州长光辰芯微电子股份有限公司 浙江省杭州市滨江区月明路567号 滨芯科技园D座 电话：0571-87718606	大连 大连长光辰芯微电子股份有限公司 辽宁省大连市高新技术产业区 汇贤园7号11楼05D室 电话：0411-39937666	
--	---	---	--